

Samsung SSD 850 EVO M.2



- Technologie V-NAND 3D (32 couches)
- Garantie 5 ans
- Disponible en 120, 250, 500 Go

Capacité	120 Go	250 Go	500 Go
Basic Kit	MZ-N5E120BW	MZ-N5E250BW	MZ-N5E500BW
EAN	8806086587327	8806086587334	8806086587341

Technologie 3D V-NAND

Augmente la densité et les performances



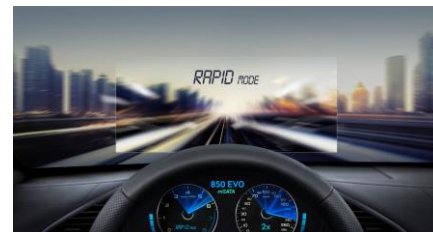
TurboWrite

Vitesse de lecture (540Mo/s)
Vitesse d'écriture (500Mo/s)



RapidMode

Traitement des données 2 fois plus rapide



Samsung SSD 850 EVO M.2

Caractéristiques principales

Format	M.2
Utilisation	PC
Interface	SATA 6.0 Gbps
Dimensions (LxHxP)	Max 80.15 x 22.15 x 1.5 (mm)
Capacités	120 Go / 250 Go / 500 Go
DRAM	Jusqu'à 1GB LPDDR2 DRAM
NAND FLASH Memory	Samsung 32 Layer 3D V-NAND
Controller	MGX
Endurance BW 120 / 250 GB	75 TBW
Endurance TBW 500 GB	150 TBW
Garantie	5 ans
Sécurité	AES 256 bits (class 0) TGC/Opal V2.0, Encrypted drive (IEEE1667)

Performances

Lecture séquentielle	120 Go	540 Mo/s
	250 Go	540 Mo/s
	500 Go	540 Mo/s
Ecriture séquentielle	120 Go	500 Mo/s
	250 Go	500 Mo/s
	500 Go	500 Mo/s
Lecture aléatoire (4 KB / QD 32)	120 Go	97 000 IOPS
	250 Go	97 000 IOPS
	500 Go	97 000 IOPS
Ecriture aléatoire (4 KB / QD 32)	120 Go	89 000 IOPS
	250 Go	89 000 IOPS
	500 Go	89 000 IOPS

Consommations

En marche	Moyenne : 3,5 Watts
En veille	Max. 50 mWatts
Norme S.M.A.R.T	Oui
Commande TRIM	Oui
Garbage Collection	Oui
Mode veille	Oui
Température en fonctionnement	0 – 70 °
Voltage	5V±5% V
Choc	1500G & 0,5ms

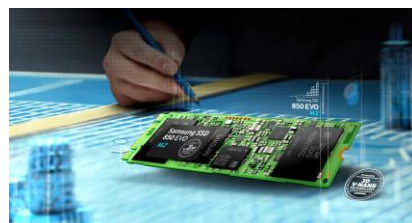
Contenu

Basic Kit	1 SSD + 1 Garantie Magician Software for SSD management
-----------	--



Technologie 3D V-NAND

L'architecture unique et innovante de la mémoire Flash V-NAND 3D de Samsung est une avancée technologique permettant de dépasser les limites de densité, les performances et l'endurance de l'architecture NAND plane traditionnelle. Fabriquée en empilant 32 couches de cellules verticalement au lieu de réduire la taille des cellules et de s'inscrire dans un espace horizontal fixe, la V-NAND 3D permet d'augmenter la densité ainsi que les performances tout en limitant son empreinte.



TurboWrite

Grâce à la technologie TurboWrite de Samsung, vous obtenez des performances optimales en matière de lecture et d'écriture et par conséquent, vous maximisez votre utilisation informatique au quotidien. En plus d'une expérience utilisateur 10% supérieure à celle du 840 EVO*, vous obtenez également des vitesses d'écriture aléatoires jusqu'à 1,9 fois plus rapides. Ceci est aussi valable pour les modèles 120/250 Go**. Le 850 EVO offre les meilleures performances en ce qui concerne les vitesses de lecture (540 Mo/s) et d'écriture (520 Mo/s) séquentielles. De plus, vous obtenez des performances aléatoires optimisées pour toutes les profondeurs de file d'attente en cas d'utilisation d'un PC Client.

*PC Mark7 (250Go) : 6700 (840 EVO) > 7600 (850 EVO)

**Ecriture aléatoire (profondeur de file d'attente : 32, 120 Go) : 36 000 IOPS (840 EVO) > 88 000 IOPS (850 EVO)



Mode Rapid

Passer à la vitesse supérieure avec le mode RAPID amélioré. Accélérez vos performances à tout moment avec le logiciel Samsung Magician qui offre le RAPID mode pour un traitement des données 2 fois plus rapides* au niveau du système. Pour ce faire, celui-ci utilise la mémoire libre du PC (DRAM) comme stockage cache. Tandis que l'utilisation de la mémoire maximale en RAPID mode était de 1Go dans la version précédente du 840 EVO, le nouveau Magician la fait passer à 4 Go dans le 850 EVO grâce à l'application d'une mémoire DRAM de 16 Go. Vous doublez également vos performances* dans toutes les profondeurs de file d'attente aléatoires.

*PCMark 7 RAW (250Go) : 7 500 > 15 000 (RAPID MODE)



*IOPS : Input-Output Operation per second

* S.M.A.R.T : Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology, fonction destinée à améliorer la fiabilité et à prévenir les pannes